

王春梅 天津 信息产业部电子第46研究所 300192

张淑珍 天津 信息产业部电子第46研究所 300192

摘要: 本文采用电感耦合等离子体发射光谱对硅单晶材料中6种金属杂质的分析进行了研究。研究了基体硅对分析元素的干扰影响及校正。采用压力溶样器制备各样品,并在低温进行杂质富集,采用ICP-AEC对杂质进行了分析,回收率在90%~105%之间。

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

Determination of Al, Cu, Cd, Cr, Mn, Mo in Silicon Single Crystal by ICP-AES

300192

300192

Abstract: A method for determination of 6 kinds of metal impurities in silicon single crystal by ICP-AES is developed . About 2000 μ g/mL silicon would have background effect on analyzed elements and this effect should be deducted by background correction.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]